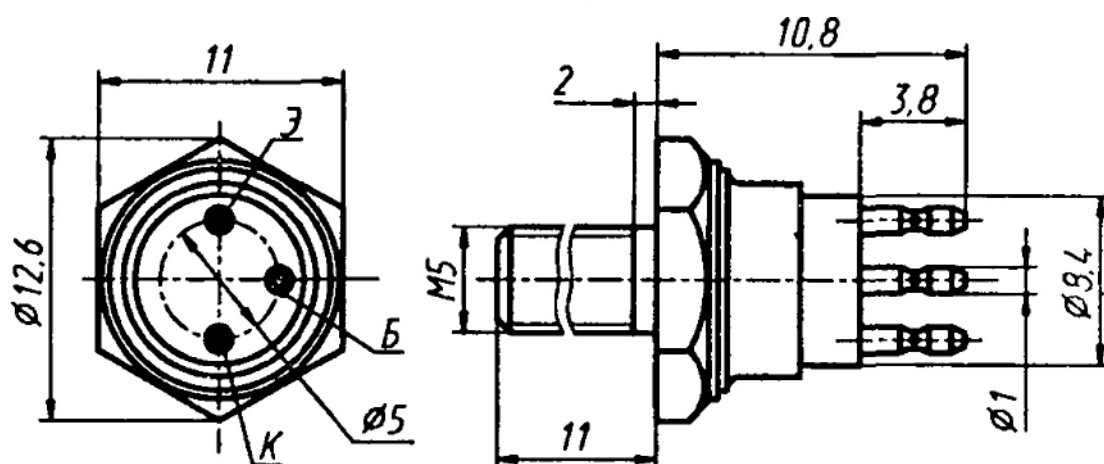


2Т921А, КТ921А, КТ921Б

Транзисторы кремниевые эпитаксиально-планарные структуры *п-р-п* усилительные линейные. Предназначены для применения в широкополосных усилителях мощности, стабилизаторах и преобразователях напряжения. Выпускаются в металлокерамическом корпусе с жесткими выводами. Тип прибора указывается на корпусе.

Масса транзистора не более 6,5 г.

2Т921А, КТ921(А,Б)



Электрические параметры

Входная мощность при $U_n = 27$ В, $f = 60$ МГц, не менее	12,5 Вт
Входная мощность в пике огибающей при $U_n = 27$ В, $f = 30$ МГц, не менее	12,5 Вт
Коэффициент усиления по мощности при $P_{\text{вых}} = 12,5$ Вт, $f = 60$ МГц:	
2Т921А, КТ921А, не менее	8
КТ921Б	5...10*...17*
Коэффициент комбинационных составляющих третьего порядка при $P_{\text{вых (по)}} = 12,5$ Вт, $f = 30$ МГц	-39*...-32*... -30 дБ
Статический коэффициент передачи тока при $U_{\text{кб}} = 10$ В, $I_k = 1$ А, не менее	10
типичное значение	45*
Модуль коэффициента передачи тока на высокой частоте при $U_{\text{кз}} = 10$ В, $I_k = 0,5$ А,	

$f = 30$ МГц	3...7,5*...10,5*
Напряжение насыщения коллектор—эмиттер при $I_k = 1$ А, $I_b = 0,2$ А, не менее	1,8 В
Граничное напряжение при $I_k = 100$ мА, не менее	32 В
Время включения при $U_{кз} = 33$ В, $I_k = 1$ А, $I_b = 0,2$ А	20...26...28* нс
Время рассасывания при $U_{кз} = 33$ В, $I_k = 1$ А, $I_{б1} = I_{б2} = 0,2$ А	60*...120*...300* нс
Время спада при $U_{кз} = 33$ В, $I_k = 1$ А, $I_{б1} = I_{б2} = 0,2$ А	24*...25*...30* нс
Емкость коллекторного перехода при $U_{кб0} = 20$ В	50 пФ
Емкость эмиттерного перехода при $U_{эб0} = 3$ В	210* пФ
Индуктивность выводов:	
эмиттерного	3,5* нГн
базового	3,5* нГн
коллекторного	3* нГн
Обратный ток коллектор—эмиттер при $R_{эб} = 10$ Ом, не более:	
$T_k = +25$ °С, $U_{кз} = 70$ В	10 мА
$T_k = +125$ °С, $U_{кз} = 65$ В	50 мА

Предельные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение коллектор—эмиттер при $R_{эб} \leq 10$ Ом:

2Т921А:

 при $T_n = -60...+125$ °С 65 В |

$T_n = +155$ °С 32 В |

КТ921А, КТ921Б:

при $T_n = -45...+125$ °С 65 В |

$T_n = +150$ °С 32 В |

Импульсное напряжение коллектор—эмиттер при $U_{эб} = -1,5$ В в схеме высокочастотного усилителя в диапазоне частот 1,5...60 МГц:

2Т921А:

$T_D = -60...+125$ °С 80 В |

$T_R = +155$ °С 60 В |

2

КТ921А, КТ921Б:	
$T_{\text{п}} = -45...+125\text{ }^{\circ}\text{C}$	80 В
$T_{\text{п}} = +150\text{ }^{\circ}\text{C}$	60 В
Постоянное напряжение коллектор—база:	
2Т921А:	
$T_{\text{п}} = -60...+125\text{ }^{\circ}\text{C}$	65 В
$T_{\text{п}} = +155\text{ }^{\circ}\text{C}$	32 В
КТ921А, КТ921Б:	
$T_{\text{п}} = -45...+125\text{ }^{\circ}\text{C}$	65 В
$T_{\text{п}} = +150\text{ }^{\circ}\text{C}$	32 В
Постоянное напряжение эмиттер—база	
Постоянный ток коллектора	
Постоянный ток базы	
Постоянная рассеиваемая мощность коллектора:	
2Т921А:	
$T_{\text{п}} = -60...+75\text{ }^{\circ}\text{C}$	12,5 Вт
$T_{\text{п}} = +125\text{ }^{\circ}\text{C}$	4,2 Вт
КТ921А, КТ921Б:	
$T_{\text{п}} = -45...+75\text{ }^{\circ}\text{C}$	12,5 Вт
$T_{\text{п}} = +125\text{ }^{\circ}\text{C}$	4,2 Вт
Средняя рассеиваемая мощность коллектора в динамическом режиме при $U_{\text{п}} = 28\text{ В}$:	
2Т921А:	
$T_{\text{к}} = -60...+100\text{ }^{\circ}\text{C}$	12,5 Вт
$T_{\text{к}} = +125\text{ }^{\circ}\text{C}$	4,2 Вт
КТ921А, КТ921Б:	
$T_{\text{к}} = -45...+75\text{ }^{\circ}\text{C}$	12,5 Вт
$T_{\text{к}} = +125\text{ }^{\circ}\text{C}$	4,2 Вт
Тепловое сопротивление переход—корпус	
Температура р-п перехода	
Температура окружающей среды:	
2Т921А	$-60...T_{\text{к}} = +125\text{ }^{\circ}\text{C}$
КТ921А, КТ921Б	$-45...T_{\text{к}} = +125\text{ }^{\circ}\text{C}$

Осевое усилие на винт не должно быть более 250 Н, на выводы транзистора — 5 Н, изгибающее усилие не более 1 Н.

Пайка выводов допускается не ближе 2 мм от корпуса транзистора паяльником, нагретым до $+260\text{ }^{\circ}\text{C}$, в течение не более 3 с, а также ближе 2 мм от корпуса при условии $T_{\text{к}} = +100\text{ }^{\circ}\text{C}$.

Допустимое значение статического потенциала 1000 В.

Области максимальных режимов

